

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2 0 0 4 年 7 月 2 2 日

出 願 番 号

Application Number:

特 願 2 0 0 4 - 2 1 4 8 4 9

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 2 1 4 8 4 9

出 願 人

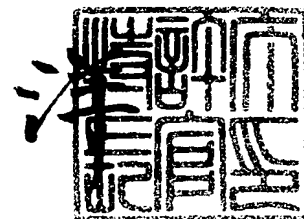
Applicant(s):

日本電信電話株式会社

2 0 0 5 年 8 月 1 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 NTTH165515
【提出日】 平成16年 7月22日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/00
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内
 【氏名】 神 好人
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内
 【氏名】 酒井 英明
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内
 【氏名】 嶋田 勝
【特許出願人】
 【識別番号】 000004226
 【氏名又は名称】 日本電信電話株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100064621
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山川 政樹
 【電話番号】 03-3580-0961
【選任した代理人】
 【識別番号】 100067138
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 黒川 弘朗
【選任した代理人】
 【識別番号】 100098394
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山川 茂樹
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 006194
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0205287

【請求項 1】

所定の組成比で供給された不活性ガスと酸素ガスとからなる第 1 プラズマを生成し、少なくとも第 1 金属と第 2 金属とから構成されたターゲットに負のバイスを印加して前記第 1 プラズマより発生した粒子を前記ターゲットに衝突させてスパッタ現象を起こし、前記ターゲットを構成する材料を基板の上に堆積することで、前記第 1 金属、第 2 金属、及び酸素とから構成された強誘電体からなる層を前記基板の上に形成する第 1 工程を備え、

前記第 1 プラズマは、電子サイクロトロン共鳴により生成されて発散磁界により運動エネルギーが与えられた電子サイクロトロン共鳴プラズマであり、

前記基板は所定温度に加熱された状態とする

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記酸素ガスの供給量は、

前記酸素ガスの減小により、前記堆積による単位時間当たりの膜厚増加量が低下し、かつ、堆積物における前記第 1 金属の組成比が低下する量以上である

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記酸素ガスの供給量は、

前記酸素ガスの増加により、前記第 1 金属の組成比が前記強誘電体の化学量論的組成より多くなる量以下である

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記強誘電体からなる層の表面に、所定の組成比で供給された不活性ガスと反応性ガスとからなる第 2 プラズマを照射する第 2 工程を備え、

前記第 2 プラズマは、電子サイクロトロン共鳴により生成されて発散磁界により運動エネルギーが与えられた電子サイクロトロン共鳴プラズマである

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 5】

請求項 4 記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記反応性ガスは、酸素ガス、窒素ガス、フッ素ガス、水素ガスの少なくとも 1 つである

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記第 1 工程において、前記基板は、強誘電体のキュリー点温度以下に加熱する

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 7】

請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記第 1 工程において、前記基板は、前記強誘電体からなる層の屈折率が、化学量論的組成の前記強誘電体の屈折率となる温度以上に加熱する

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 8】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記基板に、前記プラズマにより生成されるイオンエネルギーを制御するための電圧を印加する

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 9】

請求項 1 0 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記強誘電体は、ペロブスカイト構造、擬イルメナイト構造、タングステン・ブロンズ構造、ビスマス層状構造、及びバイクロイア構造の少なくとも 1 つである

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 1 0】

請求項 9 記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記第 1 金属はビスマスであり、前記第 2 金属はチタンであり、前記強誘電体はビスマス層状構造である

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 1 1】

請求項 1 0 記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記第 1 工程において、前記基板を 3 0 0 ～ 6 0 0 ℃ に加熱する

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【請求項 1 2】

請求項 1 ～ 1 1 のいずれか 1 項に記載の強誘電体薄膜の形成方法において、

前記ターゲットは、少なくとも前記第 1 金属と前記第 2 金属と酸素とから構成されたものである

ことを特徴とする強誘電体薄膜の形成方法。

【発明の名称】 強誘電体薄膜の形成方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、不揮発メモリ素子などに用いられる強誘電体薄膜の形成方法に関する。

【背景技術】

【0002】

マルチメディア情報化社会の拡大、さらには、ユビキタスサービスの実現に向けた研究開発が盛んに行われている。特に、ネットワーク機器、情報端末に搭載される情報を記録する装置（以下、メモリという）は、重要なキーデバイスである。ユビキタス端末に搭載されるメモリに求められる機能として、高速動作、長期保持期間、耐環境性、低消費電力、さらに、電源を切っても蓄積された情報が消去されない機能、つまり、不揮発性が必須とされている。

【0003】

従来、メモリには、半導体装置が多く用いられてきた。その中の1つとして、DRAM (Dynamic Random Access Memory) が広く使用されている。

DRAMの単位記憶素子（以下、メモリセルという）では、1個の蓄積容量と1個のMOSFET (Metal-oxide-semiconductor field effect transistor) からなり、選択されたメモリセルの蓄積容量に蓄えられた電荷の状態に対応する電圧を、ビット線から電気的なデジタル信号の「on」あるいは「off」として取り出すことで、記憶されているデータを読み出す（非特許文献1参照）。

【0004】

しかし、DRAMでは、電源を切ると蓄積容量の状態を維持することが不可能となり、蓄積された情報が消去されてしまう。言い換えると、DRAMは揮発性のメモリ素子である。また、よく知られているように、DRAMでは、データを再び書き込むリフレッシュ動作が必要となり、動作速度が低下するという欠点もある。

【0005】

電源を切ってもデータが揮発しない機能である不揮発性のメモリとしては、ROM (Read only Memory) がよく知られているが、記録されているデータの消去や変更が不可能である。

また、書き換え可能な不揮発性のメモリとして、EEPROM (Electrically erasable programmable read only memory) を用いたフラッシュメモリ (Flash memory) が開発されている（特許文献1，非特許文献1参照）。フラッシュメモリは、実用的な不揮発性メモリとして、多くの分野で使用されている。

【0006】

代表的なフラッシュメモリのメモリセルは、MOSFETのゲート電極部が、制御ゲート電極と浮遊ゲート電極を有した複数の層からなるスタックゲート (Stack gate) 構造となっている。フラッシュメモリでは、浮遊ゲートに蓄積された電荷の量により、MOSFETの閾値が変化することを利用して、データの記録を可能としている。

【0007】

フラッシュメモリのデータの書き込みは、ドレイン領域に高電圧を印加して発生したホットキャリアがゲート絶縁膜のエネルギー障壁を乗り越えることで行う。また、ゲート絶縁膜に高電界を印加してF-N (Fowler-Nordheim) トンネル電流を流すことで、半導体基板から浮遊ゲートに電荷（一般的には電子）を注入することで、データの書き込みが行われる。データの消去は、ゲート絶縁膜に逆方向の高電界を印加することで、浮遊ゲートから電荷を引き抜くことにより行われる。

【0008】

フラッシュメモリは、DRAMのようなリフレッシュ動作が不要な反面、F-Nトンネル現象を用いるために、DRAMに比べてデータの書き込み及び消去に要する時間がけた違いに長くなってしまいうという問題がある。さらに、データの書き込み・消去を繰り返

り、ノード配線族が劣化するのを、直交伏反函数がある性反制限で何とかしているという問題もある。

【0009】

上述したフラッシュメモリに対し、新たな不揮発性メモリとして、強誘電体の分極を用いた強誘電体メモリ（以下、F e R A M (Ferroelectric RAM) や、強磁性体の磁気抵抗を用いた強磁性体メモリ（以下、M R A M (Magnetoresist RAM) という）などが注目されており、盛んに研究されている。

この中で、F e R A Mは、既に実用化されていることもあり、諸処の課題を解決できれば、可搬型メモリだけでなくロジックのD R A Mも置き換えできると期待されている。

【0010】

強誘電体には、酸化物強誘電体（強誘電体セラミックスとも呼ばれる）とポリフッ化ビニリデン（P V D F）に代表されるような高分子強誘電体、B a M g F₄などのフッ化物強誘電体がある。酸化物強誘電体とフッ化物強誘電体は、分極を担う原子のわずかな変位によって分極反転が起きる。一方、高分子強誘電体では、共有結合で長く結合した分子鎖のコンフォメーション（結合形態）変化を素過程とする個々の分子鎖の回転によって、分極反転が起きる。

【0011】

酸化物強誘電体は、B a T i O₃、P b T i O₃などのペロブスカイト構造（Perovskite）、L i N b O₃、L i T a O₃などの擬イルメナイト構造（Pseudo-ilmenite）、P b N b₃O₆、B a₂N a N b₅O₁₅などのタングステン・ブロンズ（T B）構造（Tungsten-bronze）、S r B i₂T a₂O₉、B i₄T i₃O₁₂などのビスマス層状構造（Bismuth layer-structure ferroelectric, BLSF）等、L a₂T i₂O₇などのパイロクロア構造（Pyrochlore）に分類される。

【0012】

また、高分子強誘電体は、ポリフッ化ビニリデン（P V D F）を始め、フッ化ビニリデン（P D V）と三フッ化エチレンの共重合体のP（V D F／T r E F）などがあり、高分子の重合反応により作製される。強誘電体についての詳しくは、非特許文献2を参考されたい。

【0013】

上述した強誘電体材料のうち、F e R A Mには主に酸化物強誘電体が使用される。さらに、酸化物強誘電体の中でよく使用されているのは、ペロブスカイト構造を持つ強誘電体（以下、ペロブスカイト型強誘電体と呼ぶ）の中でもP b（Z r，T i）O₃（P Z T）で代表される鉛系強誘電体である。しかしながら、鉛含有物や鉛酸化物は、労働安全衛生法により規制される材料であり、生態への影響や環境負荷の増大などが懸念される。このため欧米では、生態学的見知及び公害防止の面から規制対象となりつつある。

【0014】

近年の環境負荷軽減の必然性から、非鉛系（無鉛）で鉛系強誘電体の性能に匹敵する強誘電体材料が世界的に注目されており、この中でも無鉛ペロブスカイト型強誘電体やビスマス層状構造強誘電体（B L S F）が有望とされている。しかし、鉛系強誘電体に比べ分極量が小さく成膜法・加工法ともに課題が多いのも事実である。

【0015】

フラッシュメモリの代わりとして期待されるF e R A Mには、主に、スタック型とF E T型に分類される。

スタック型は、1トランジスタ1キャパシタ型F e R A Mとも呼ばれ、この構造から図8に示すようなスタック型キャパシタを持つものと、プレーナ型キャパシタを持つもの、立体型キャパシタを持つものがある。また、スタック型には、1トランジスタ1キャパシタ型F e R A Mやこれを2つ重ねて安定動作化させた2トランジスタ2キャパシタ型F e R A Mがある。

【0016】

図8に示すスタック型のF e R A Mは、半導体基板801の上に、ソース802，ドレ

インのり、ノード絶縁膜のり4を介して取りつけたノード電極のり5よりなるMOSトランジスタを備え、MOSトランジスタのソース802に、下部電極811、強誘電体からなる誘電体層812、上部電極813からなるキャパシタが接続している。図8の例では、ソース電極806により上記キャパシタがソース802に接続している。また、ドレイン803にはドレイン電極807が接続し、電流計が接続している。

【0017】

これらの構造は、強誘電体からなる誘電体層812の分極の向きをソース・ドレイン間（チャンネル821）に流れる電流として検出することで、「on」あるいは「off」のデータとして取り出す機能を持っている。強誘電体の分極は、電圧を印加してなくても保持できることから不揮発性を有するが、この構造では、データ読み出し時にデータを破壊してしまい、データの再書き込みが必要となり高速性にかけるという問題や、1つの素子の占有する面積が大きい、高集積化には向かないという欠点がある。

【0018】

上述したスタック型FeRAMに対し、FET型FeRAMは、次世代を担うFeRAMとして期待されている。FET型FeRAMは、1トランジスタ型FeRAMとも呼ばれ、この構造から、MOSFETのゲート電極とチャンネル領域のゲート絶縁膜の代わりに強誘電体膜を配置したMFS（Metal-ferroelectric-semiconductor）型FeRAM、MOSFETのゲート電極の上に強誘電体膜を配置したMFMS（Metal-ferroelectric-metal-insulator-semiconductor）型FeRAM、さらにMOSFETのゲート電極とゲート絶縁膜の間に強誘電体膜を配置した図9に示すようなMFI S（Metal-ferroelectric-insulator-semiconductor）型FeRAMなどの1トランジスタ型FeRAMがある（非特許文献3参照）。

【0019】

図9に示すMFI Sでは、半導体基板901の上に、ソース902、ドレイン903を備え、ソース・ドレイン間に配置されたゲート絶縁膜904の上に、強誘電体からなる誘電体層905を備え、誘電体層905の上にゲート電極906を備える。ソース902にはソース電極907を介してソース電圧が印加され、ドレイン903にはドレイン電極908を介して電流計が接続している。

【0020】

これらのFeRAMは、MOSFETの動作に強誘電体の分極を適用させたものであり、分極の状態により、ゲート絶縁膜904直下の半導体表面にチャンネル921が形成される場合と、形成されない場合との状態を作り出し、このときのソース・ドレイン間の電流値を読み取り、電氣的なデジタル信号の「on」あるいは「off」として取り出す機能を持っている。

【0021】

FET型FeRAMでは、動作原理から、データ読み出しを行っても、強誘電体の分極量は変化しないことから非破壊読み出しが可能であり、高速動作が期待されている。また、1トランジスタ1キャパシタ型FeRAMに比べて専有面積も小さくできることから、高集積化に有利である特徴を持つ。

しかしながら、実際には、1トランジスタ型FeRAMのうちMFI S型FeRAM（図9）では、強誘電体膜と半導体の間にゲート絶縁膜があるために、強誘電体の分極量を打ち消すような減分極電界が発生する。

【0022】

さらに、一般的に非晶質（アモルファス）である絶縁膜の上に分極特性と配向性を持つ高品質な高誘電体を成膜しなければならない。ところが、後に説明する既存の成膜手法を用いては、絶縁膜上に高配向性の強誘電体を形成することが難しかった。このため、従来技術で作製されたMFI S型FeRAMは、減分極電界により分極が持ちこたえることができず、長時間のデータ保持ができなかった。さらに、半導体の上に形成する絶縁膜の品質が乏しい場合、電界により生じるリーク電流によって、強誘電体の分極量がさらに低下してしまう。これらのために、現状のMFI S型FeRAMにおいては、メモリとしての

動作のリーク保持期間（リーク電圧）が 10^{-10} V程度に留まっておらず、大用にはほとと違いのが現状である。

【0023】

ところで、MF MIS型FeRAMにおいては、結晶の金属電極（PtやSrRuO₂などが一般的）の上に強誘電体を形成できるため、MF IS型FeRAM構造のように絶縁膜の上に強誘電体を形成する必要がなく高品質な成膜ができる。しかしながら、強誘電体は、金属上に対してもいまだ安定した成膜方法が提案されておらず、やはり、半導体上の絶縁膜による減分極電界による分極低下が問題となり長期のメモリ保持が実現されていない。

【0024】

一方、MF S型FeRAMでは、半導体上の絶縁膜を必要としないために、原理的に減分極電界による分極の低下を回避できる。しかし、ゾルゲル法やMOCVD法などの強誘電体成膜方法では高温の成膜温度が必要となるために、Siなどの半導体表面が酸化又は変質してしまい、界面に酸化膜や欠陥を多く形成してしまう。この結果、半導体と強誘電体との界面に酸化膜（界面酸化膜）が形成されてしまった場合、MF IS型FeRAMと同様に減分極電界が生じてしまう。

【0025】

界面酸化膜が形成されなくても、界面に欠陥準位を多く形成した場合、電荷蓄積の電荷の影響が大きくなり、正確なメモリ動作ができなくなる。また、形成した強誘電体膜の品質が低い場合、膜中にリーク電流が流れてしまい長期間の分極特性を保持できないことが多く報告されている。

【0026】

上述したFeRAMなどでは、基体上への酸化物強誘電体の形成が重要である。現在までに様々な形成装置及び種々の薄膜形成方法が試みられている。例えば、ゾルゲル（sol-gel）法と有機金属熱分解（Metal-organic deposition, MOD）を含む化学溶液堆積法（Chemical solution deposition, CSD）、有機金属化学気相堆積法（Metal-organic chemical vapor deposition, MOCVD又はMOVPE）、パルス・レーザー・デポジション（Pulsed laser deposition, PLD）、液体ミスト化学堆積法（Liquid source misted chemical deposition, LSMCD）、電気泳動堆積法（Electro-phoretic deposition, EPD）、高周波スパッタリング法（rf-sputtering、RFスパッタ法やマグネトロンスパッタ法とも呼ぶ）、ECRスパッタ法（Electron cyclotron resonance sputtering）などが挙げられる。

【0027】

これらの成膜方法のうち主流となっているのは、ゾルゲル法やMOD法と呼ばれるCSD法である。CSD法は、強誘電体の基材を有機溶媒に溶解し、これを基体に塗布・焼結を繰り返して膜を形成する方法であり、簡便で比較的大面積に強誘電体膜が形成できるのが特徴である。CSD法は、塗布する溶液の組成を制御することで任意の組成を持つ強誘電体膜が形成でき、多くの研究機関から報告がなされている。

【0028】

しかし、塗布する基体によっては濡れ性が悪く形成できないこともあること、形成した膜中に溶液に用いる溶媒が残されてしまい良好な膜質が得られないことなどの問題がある。また、CSD法では、焼結させるための温度を強誘電体膜のキュリー温度よりも高くする必要があるので、温度や雰囲気の影響が大きい場合、良好な特性の膜が全く得られないといった問題を抱える。

【0029】

また、CSD法以外の方法による強誘電体膜の形成も試みられている。例えば、エキシマレーザーなどの強力なレーザー光源で強誘電体原料のターゲットをスパッタすることで、良好な膜質の強誘電体膜が形成できるPLD法が注目されている。

しかし、この方法では、ターゲット面内においてレーザーが照射される部分の面積は非常に小さく、小さな照射面からスパッタされて供給される原料に大きな分布が生じる。このためにPLD法では、基体に形成される強誘電体の膜厚・膜質などに大きな面内分布を生

し、また、同一基板で形成しても互に異なった付着になるなど、付着性について大きな問題がある。

【0030】

しかし、この特性は、条件を詳細に検討するのには向いており、この特性を生かして成膜特性を検討する手法としてコンビナトリアル法が注目されている。しかしながら、工業的な観点からは、大面積に再現性よく形成できる手法が必須であり、現在のPLD法は、工業的な使用は困難であるといえる。

【0031】

上述した種々の膜形成方法に対し、強誘電体膜の形成方法としてスパッタリング法（単にスパッタ法ともいう）が注目されている。スパッタ法は、危険度の高いガスや有毒ガスなどを用いることなく、堆積する膜の表面凹凸（表面モフォロジ）が比較的良いなどの理由により、有望な成膜装置・方法の1つになっている。スパッタ法において、化学量論的組成の強誘電体膜を得るための優れた装置・方法として、酸素ガスや窒素ガスを供給し、膜中の酸素や窒素が欠落するのを防止する反応性スパッタ装置・方法が有望である。

【0032】

従来から使用されているRFスパッタ法（従来スパッタ法）において、酸化物強誘電体を堆積するときには、対象となる化合物（焼結体）ターゲットを用いる。しかしながら、従来スパッタ法では、不活性ガスとしてアルゴン、反応性ガスとして酸素を用いて酸化物強誘電体を形成した場合、基板上に形成された強誘電体膜中の酸素が充分に取り込まれずに、良好な膜質の強誘電体が得られないという問題があった。

【0033】

このため、強誘電体を堆積した後に、加熱炉などを用いた酸素中でのアニーリングと呼ばれる加熱処理により、基体の上に形成した強誘電体膜の膜質を改善する必要があった。従って、上記従来スパッタ法では、アニーリングという工程が追加され、製造プロセスに煩雑性が増すという問題があった。また、このアニーリング工程では、一定の膜質を得るようには制御するため、温度などの条件を厳密に管理する必要があった。加えて、形成する膜の材質によっては、アニーリング処理を行うことができない場合もあった。

【0034】

また、スパッタ膜の膜品質を改善する方法として、電子サイクロトロン共鳴（ECR）によりプラズマを発生させ、このプラズマの発散磁界を利用して作られたプラズマ流を基板に照射し、同時に、ターゲットと接地間に高周波又は負の直流電圧を印加し、上記ECRで発生させたプラズマ流中のイオンをターゲットに引き込み衝突させてスパッタリングし、膜を基板に堆積させるECRスパッタ法がある。

【0035】

従来のスパッタ法では、0.1Pa程度以上のガス圧力でないと安定なプラズマは得られないのに対し、ECRスパッタ法では、安定なECRプラズマが0.01Pa台の圧力で得られる特徴をもつ。また、ECRスパッタ法は、高周波又は負の直流高電圧により、ECRにより生成した粒子をターゲットに当ててスパッタリングを行うため、低い圧力でスパッタリングができる。

【0036】

ECRスパッタ法では、基板にECRプラズマ流とスパッタされた粒子が照射される。ECRプラズマ流中のイオンは、発散磁界により10eVから数10eVのエネルギーを持っている。また、気体が分子流として振る舞う程度の低い圧力でプラズマを生成・輸送しているため、基板に到達するイオンのイオン電流密度も大きく取れる。従って、ECRプラズマ流中のイオンは、スパッタされて基板上に飛来した原料粒子にエネルギーを与えると共に、原料粒子と酸素との結合反応を促進することとなり、堆積した膜の膜質が改善される。

【0037】

ECRスパッタ法では、低い基板温度で高品質の膜が形成できることが特徴となっている。ECRスパッタ法でいかに高品質な薄膜を堆積し得るかは、例えば、特許文献2、特

訂文願の、非特許文献を参照されたい。

さらに、ECRスパッタ法は、膜の堆積速度が比較的安定しているため、ゲート絶縁膜などの極めて薄い膜を、膜厚の制御よく形成するのに適している。また、ECRスパッタ法で堆積した膜の表面モフォロジは、原子スケールのオーダーで平坦である。従って、ECRスパッタ法は、高誘電率ゲート絶縁膜の形成するだけでなく、前述したFeRAMに必要な強誘電体膜の形成や金属電極膜の形成にとって有望な方法であると言える。

【0038】

ECRスパッタ法を用いた強誘電体膜の検討についてもいくつか報告されている。例えば、特許文献4、特許文献5、非特許文献5では、バリウム又はストロンチウムを含む強誘電体の製造について報告している。また、非特許文献6では、 $\text{Ba}_2\text{NaNi}_5\text{O}_{15}$ の製造について報告している。さらに、非特許文献7では、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ の製造について報告している。

【0039】

なお、出願人は、本明細書に記載した先行技術文献情報で特定される先行技術文献以外には、本発明に関連する先行技術文献を出願時までに発見するには至らなかった。

【特許文献1】特開平8-031960号公報

【特許文献2】特許第2814416号公報

【特許文献3】特許第2779997号公報

【特許文献4】特開平10-152397号公報

【特許文献5】特開平10-152398号公報

【非特許文献1】サイモン・ジー著、「フィジクス・オブ・セミコンダクター・デバイス」、1981年、(S.M.Sze, "Physics of Semiconductor Devices", John Wiley and Sons, Inc.)

【非特許文献2】塩崎忠 監修、「強誘電体材料の開発と応用」、シーエムシー出版

【非特許文献3】猪俣浩一郎、田原修一、有本由弘編、「MRAM技術—基礎からLSI応用まで—」、サイベック

【非特許文献4】天沢他のジャーナルオブバキュームサイエンスアンドテクノロジー、第B17巻、第5号、2222頁、1999年(J. Vac. Sci. Technol., B17, no. 5, 2222 (1999)).

【非特許文献5】松岡らのジャーナル・アプライド・フィジクス、第76巻、第3号、1768頁、1994年(J. Appl. Phys., 76(3), 1768, (1994)).

【非特許文献6】渡津らの「粉体及び粉末冶金」、第44号、86頁、1997年

【非特許文献7】増本らのアプライド・フィジクス・レター、第58号、243頁、1991年、(Appl. Phys. Lett., 58, 243, (1991)).

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0040】

しかしながら、従来では、ECRスパッタ法を用いても、先人らは従来スパッタ法と同様の方法として捉えた思想により条件を選択し、強誘電体材料からなる膜を形成しようとしていた。このため、従来では、ECRスパッタ法を用いて強誘電体膜を形成しても、FeRAMに適用できる良好な強誘電性を示すことができなかった。

本発明は、以上で説明した問題点を解決するために成されたものであり、ECRスパッタ法において、酸素流量を制御することなどにより、良好な強誘電体特性を持つ強誘電体膜が形成できるようにすることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0041】

本発明に係る強誘電体薄膜の形成方法は、所定の組成比で供給された不活性ガスと酸素ガスとからなる第1プラズマを生成し、少なくとも第1金属と第2金属とから構成されたターゲットに負のバイスを印加して第1プラズマより発生した粒子をターゲットに衝突させてスパッタ現象を起こし、ターゲットを構成する材料を基板の上に堆積することで、第

第1金属，第2金属，及び酸素とから構成された強誘電体からなる層を基板の上に形成する第1工程を備え、第1プラズマは、電子サイクロトロン共鳴により生成されて発散磁界により運動エネルギーが与えられた電子サイクロトロン共鳴プラズマであり、基板は所定温度に加熱された状態とするようにしたものである。

供給する酸素の量により、強誘電体層における第1金属，第2金属，及び酸素の比率が制御される。

【0042】

上記強誘電体薄膜の形成方法において、酸素ガスの供給量は、酸素ガスの減小により、堆積による単位時間当たりの膜厚増加量が低下し、かつ、堆積物における第1金属の組成比が低下する量以上であればよい。また、酸素ガスの供給量は、酸素ガスの増加により、第1金属の組成比が強誘電体の化学量論的組成より多くなる量以下であればよい。

【0043】

上記強誘電体薄膜の形成方法において、強誘電体からなる層の表面に、所定の組成比で供給された不活性ガスと反応性ガスとからなる第2プラズマを照射する第2工程を備えるようにしてもよい。なお、第2プラズマは、電子サイクロトロン共鳴により生成されて発散磁界により運動エネルギーが与えられた電子サイクロトロン共鳴プラズマであり、この場合、反応性ガスは、酸素ガス、窒素ガス、フッ素ガス、水素ガスの少なくとも1つであればよい。

【0044】

上記強誘電体薄膜の形成方法において、第1工程において、基板は、強誘電体のキュリー点温度以下に加熱すればよい。また、基板は、強誘電体からなる層の屈折率が、化学量論的組成の強誘電体の屈折率となる温度以上に加熱すればよい。

また、基板に、プラズマにより生成されるイオンエネルギーを制御するための電圧を印加してもよい。

【0045】

また、強誘電体は、ペロブスカイト構造，擬イルメナイト構造，タングステン・ブロンズ構造，ピスマス層状構造，及びバイクロイア構造の少なくとも1つである。また、第1金属はピスマスであり、第2金属はチタンであり、強誘電体はピスマス層状構造である。このとき、第1工程において、基板を300～600℃に加熱すればよい。なお、ターゲットは、少なくとも第1金属と第2金属と酸素とから構成されたものである。

【発明の効果】

【0046】

以上説明したように、本発明によれば、少なくとも第1金属と第2金属とから構成されたターゲットを用い、所定の組成比で供給された不活性ガスと酸素ガスとからなる電子サイクロトロン共鳴による第1プラズマを用いたスパッタ法により、第1金属，第2金属，及び酸素とから構成された強誘電体からなる層を基板の上に形成するようにしたので、供給する酸素の量により、強誘電体層における第1金属，第2金属，及び酸素の比率を制御できるようになり、良好な強誘電体特性を持つ強誘電体膜が形成できるようになるという優れた効果が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0047】

以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。

図1は、本発明の実施形態における強誘電体薄膜の形成方法例を説明するための概略的な工程図である。図1に示す製造工程では、シリコン基板101の上に、二酸化シリコンからなる絶縁層102、ルテニウムからなる下部電極層103、五酸化タンタルと二酸化シリコンの多層構造からなる多層絶縁層104、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ からなる強誘電体層105、金からなる上部電極106を順次積層したものであり、この順に沿って説明する。

【0048】

まず、図1(a)に示すように、主表面が面方位(100)で抵抗率が $1\sim 2\Omega\cdot\text{cm}$ のp形のシリコン基板101を用意し、シリコン基板101の表面を硫酸と過酸化水素水

の此口假し靴小と布ノソル小糸小とにより凡付けし、このめと靴床とせる。

ついで、洗浄・乾燥したシリコン基板101の上に、絶縁層102が形成された状態とする。

【0049】

ここで、本実施の形態においては、各層の形成には、図2に示すようなECRスパッタ装置を用いる。

ここで、図2に示すECRスパッタ装置について説明すると、まず、処理室201とこれに連通するプラズマ生成室202とを備えている。処理室201は、図示していない真空排気装置に連通し、真空排気装置によりプラズマ生成室202とともに内部が真空排気される。

【0050】

処理室201には、膜形成対象の基板101が固定される基板ホルダ204が設けられている。基板ホルダ204は、図示しない回転機構により所望の角度に傾斜し、かつ回転可能とされている。基板ホルダ204を傾斜して回転させることで、堆積させる材料による膜の面内均一性と段差被覆性とを向上させることが可能となる。

また、処理室201内のプラズマ生成室202からのプラズマが導入される開口領域において、開口領域を取り巻くようにリング状のターゲット205が備えられている。

【0051】

ターゲット205は、絶縁体からなる容器205a内に載置され、内側の面が処理室201内に露出している。また、ターゲット205には、マッチングユニット221を介して高周波電源222が接続され、例えば、13.56MHzの高周波が印加可能とされている。ターゲット205が導電性材料の場合、直流を印加するようにしても良い。なお、ターゲット205は、上面から見た状態で、円形状だけでなく、多角形状態であっても良い。

【0052】

プラズマ生成室202は、真空導波管206に連通し、真空導波管206は、石英窓207を介して導波管208に接続されている。導波管208は、図示していないマイクロ波発生部に連通している。また、プラズマ生成室202の周囲及びプラズマ生成室202の上部には、磁気コイル（磁場形成手段）210が備えられている。これら、マイクロ波発生部、導波管208、石英窓207、真空導波管206により、マイクロ波供給手段が構成されている。なお、導波管208の途中に、モード変換器を設けるようにする構成もある。

【0053】

図2のECRスパッタ装置の動作例について説明すると、まず、処理室201及びプラズマ生成室202内を真空排気した後、不活性ガス導入部211より不活性ガスであるアルゴンガスを導入し、また、反応性ガス導入部212より反応性ガスを導入し、プラズマ生成室202内を例えば $10^{-5} \sim 10^{-4}$ Pa程度の圧力にする。この状態で、磁気コイル210よりプラズマ生成室202内に0.0875Tの磁場を発生させた後、導波管208、石英窓207を介してプラズマ生成室202内に2.45GHzのマイクロ波を導入し、電子サイクロトロン共鳴（ECR）プラズマを発生させる。

【0054】

ECRプラズマは、磁気コイル210からの発散磁場により、基板ホルダ204の方向にプラズマ流を形成する。生成されたECRプラズマのうち、電子は磁気コイル210で形成される発散磁場によりターゲット205の中を貫通して基板101の側に引き出され、基板101の表面に照射される。このとき同時に、ECRプラズマ中のプラスイオンが、電子による負電荷を中和するように、すなわち、電界を弱めるように基板101側に引き出され、成膜している層の表面に照射される。このように各粒子が照射される間に、プラスイオンの一部は電子と結合して中性粒子となる。

【0055】

なお、図2の薄膜形成装置では、図示していないマイクロ波発生部より供給されたマイ

ノロ波電力で、石英窓207において一旦吸収し、ノロ波を生成室202の上部の真空導波管206に、プラズマ生成室202の側方から石英窓207を介して結合させている。このようにすることで、石英窓207に対するターゲット205からの飛散粒子の付着が、防げるようになり、ランニングタイムを大幅に改善できるようになる。

【0056】

絶縁層102の形成では、上述したECRスパッタ装置を用い、処理室201内の基板ホルダ204にシリコン基板101を固定し、ターゲット205として純シリコン(Si)を用い、プラズマガスとしてアルゴン(Ar)と酸素ガスを用いたECRスパッタ法により、シリコン基板101の上に、表面を覆う程度にSi-O分子によるメタルモードの絶縁層102を形成する。

【0057】

図2に示すECRスパッタ法において、図示していないマイクロ波発生部より、例えば2.45GHzのマイクロ波(例えば500W)を供給し、これを導波管208、石英窓207、真空導波管206を介してプラズマ生成室202の内部に導入する。また、プラズマ生成室202内に、不活性ガス導入部211より、例えば希ガスであるArガスを流量20sccm程度で導入し、プラズマ生成室202の内部を例えば 10^{-3} Pa程度の圧力に設定する。

【0058】

加えて、プラズマ生成室202には、磁気コイル210にコイル電流を例えば28Aを供給することで電子サイクロトロン共鳴条件の磁場を与え、上記マイクロ波の導入により、プラズマ生成室202にArのプラズマが生成された状態とする。なお、sccmは流量の単位あり、 $0^{\circ}\text{C}\cdot 1$ 気圧の流体が1分間に 1cm^3 流れることを示す。

【0059】

上述したことにより生成されたプラズマは、磁気コイル210の発散磁場によりプラズマ生成室202より処理室201の側に放出される。また、プラズマ生成室202の出口に配置されたターゲット205に、高周波電源222より高周波電力(例えば500W)を供給する。このことにより、ターゲット205にAr粒子が衝突してスパッタリング現象が起こり、Si粒子がターゲット205より飛び出す。

【0060】

ターゲット205より飛び出したSi粒子は、プラズマ生成室202より放出されたプラズマ、及び、反応性ガス導入部212より導入されてプラズマにより活性化された酸素ガスと共にシリコン基板101の表面に到達し、活性化された酸素により酸化され二酸化シリコンとなる。

【0061】

以上のことにより、シリコン基板101上に二酸化シリコンからなる例えば100nm程度の膜厚の絶縁層102が形成された状態とすることができる(図1(a))。所定の膜厚まで形成した後、マイクロ波電力の供給を停止するなどにより、プラズマ照射を停止し、成膜を停止する。

【0062】

なお、絶縁層102は、この後に形成する下部電極層103と上部電極106に電圧を印加した時に、シリコン基板101に電圧が洩れて、所望の電気的特性に影響することがないように絶縁を図るものである。従って、絶縁層102は、二酸化シリコン以外の他の絶縁材料から構成してもよい。また、上述したECRスパッタによる膜の形成では、シリコン基板101に対して加熱はしていないが、シリコン基板101を加熱しながら膜の形成を行ってもよい。

【0063】

以上のようにして絶縁層102を形成した後、基板101を装置内より大気中に搬出し、ついで、ターゲット205として純ルテニウム(Ru)を用いた図2同様のECRスパッタ装置の基板ホルダ204に、基板101を固定する。引き続いて、プラズマガスとしてアルゴン(Ar)とキセノン(Xe)を用いたECRスパッタ法により、図1(b)に

シリコンに、絶縁層102の上に、表面を覆う程度に、多層絶縁層104が形成された状態とする。

【0064】

Ru膜の形成について詳述すると、Ruからなるターゲット205を用いた図2に示すECRスパッタ装置において、図示していないマイクロ波発生部より、例えば2.45GHzのマイクロ波（例えば500W）を供給し、これを導波管208、石英窓207、真空導波管を介してプラズマ生成室202内に導入する。また、プラズマ生成室202内に、不活性ガス導入部211より、例えば流量7sccmで希ガスであるArガスを導入し、例えば流量5sccmでXeガスを導入し、プラズマ生成室202の内部を、例えば 10^{-2} ~ 10^{-3} Pa台の圧力に設定する。

【0065】

加えて、プラズマ生成室202には、磁気コイル210にコイル電流を例えば26Aを供給することで電子サイクロトロン共鳴条件の磁場を与え、上記マイクロ波の導入により、プラズマ生成室202にArとXeのプラズマが生成した状態とする。生成されたプラズマは、磁気コイル210の発散磁場によりプラズマ生成室202より処理室201側に放出される。また、プラズマ生成室202の出口に配置されたターゲット205に、高周波電極供給部より高周波電力（例えば500W）を供給する。このことにより、ターゲット205にAr粒子が衝突してスパッタリング現象が起こり、Ru粒子がターゲット205より飛び出す。ターゲット205より飛び出したRu粒子は、シリコン基板101の絶縁層102表面に到達し堆積する。

【0066】

以上のことにより、絶縁層102の上に、例えば10nm程度の膜厚の下部電極層103が形成された状態が得られる（図1（b））。下部電極層103は、この後に形成する上部電極106との間に電圧を印加した時に、強誘電体層105と多層絶縁層104に電圧が印加できるようにするものである。従って、導電性が持てればルテニウム以外から下部電極層103を構成してもよく、また、膜厚も10nmに限るものではなく、これより厚くてもよく薄くてもよい。

【0067】

ところで、上述したようにECRスパッタ法によりRuの膜を形成するときに、シリコン基板101を400℃に加熱したが、加熱しなくても良い。ただし、加熱を行わない場合、ルテニウムの二酸化シリコンへの密着性が低下するため、剥がれが生じる恐れがあり、これを防ぐために、基板を加熱して膜を形成する方が望ましい。

以上のようにして所望の膜あるにRuを堆積した後、マイクロ波電力の供給を停止するなどにより、プラズマ照射を停止し、成膜を停止する。

【0068】

以上のようにして下部電極層103を形成した後、基板101を装置内より大気中に搬出し、ついで、ターゲット205として純タンタル（Ta）を用いた図2同様のECRスパッタ装置の基板ホルダ204に、基板101を固定する。引き続いて、プラズマガスとしてアルゴン（Ar）と酸素ガスとを用いたECRスパッタ法により、図1（c）に示すように、下部電極層103の上に、表面を覆う程度に、多層絶縁層104が形成された状態とする。以下に説明するように、Ta-O分子によるメタルモード膜を形成し、多層絶縁層104とする。

【0069】

Ta-O分子によるメタルモード膜の形成について詳述すると、タンタルからなるターゲット205を用いた図2に示すECRスパッタ装置において、図示していないマイクロ波発生部より、例えば2.45GHzのマイクロ波（例えば500W）を供給し、これを導波管208、石英窓207、真空導波管を介してプラズマ生成室202内に導入する。また、プラズマ生成室202内に、不活性ガス導入部211より、例えば流量7sccmで希ガスであるArガスを導入し、例えば流量20sccmでArガスを導入し、プラズマ生成室202の内部を、例えば 10^{-3} Pa台の圧力に設定する。

【 0 0 7 0 】

加えて、プラズマ生成室 2 0 2 には、磁気コイル 2 1 0 にコイル電流を例えば 2 8 A を供給することで電子サイクロトロン共鳴条件の磁場を与え、上記マイクロ波の導入により、プラズマ生成室 2 0 2 に A r のプラズマが生成した状態とする。生成されたプラズマは、磁気コイル 2 1 0 の発散磁場によりプラズマ生成室 2 0 2 より処理室 2 0 1 の側に放出される。また、プラズマ生成室 2 0 2 の出口に配置されたターゲット 2 0 5 に、高周波電極供給部より高周波電力（例えば 5 0 0 W）を供給する。このことにより、ターゲット 2 0 5 に A r 粒子が衝突してスパッタリング現象を起こし、T a 粒子がターゲット 2 0 5 より飛び出す。

【 0 0 7 1 】

ターゲット 2 0 5 より飛び出した T a 粒子は、プラズマ生成室 2 0 2 より放出されたプラズマ、及び反応性ガス導入部 2 1 2 より導入されてプラズマにより活性化された酸素ガスと共にシリコン基板 1 0 1 の下部電極層 1 0 3 表面に到達し、活性化された酸素により酸化され五酸化タンタルとなる。

【 0 0 7 2 】

以上のことにより、まず、下部電極層 1 0 3 の上に五酸化タンタル膜を形成する。

続いて、図 1（a）を用いて説明した二酸化シリコンの堆積と同様に、純シリコンからなるターゲット 2 0 5 を用いた E C R スパッタ法により、上記五酸化タンタル膜の上に二酸化シリコン膜が形成された状態とする。

上述した五酸化タンタル膜と二酸化シリコン膜の形成工程を繰り返し、五酸化タンタル膜と二酸化シリコン膜との多層膜を例えば、5 n m 程度形成することで、多層絶縁層 1 0 4 が得られる（図 1（c））。

【 0 0 7 3 】

なお、五酸化タンタル膜と二酸化シリコン膜からなる多層絶縁層 1 0 4 は、この後に形成する強誘電体層 1 0 5 に電圧を印加した時に、強誘電体膜に印加される電圧を制御するために用いる。従って、強誘電体層 1 0 5 に印加される電圧を制御することができれば、五酸化タンタル膜と二酸化シリコン膜の多層構造以外から多層絶縁層 1 0 4 を構成してもよく、単層から構成してもよい。また、膜厚も、5 n m に限るものではない。

なお、上述した E C R スパッタ法では、シリコン基板 1 0 1 に対して加熱はしていないが、加熱しても良い。この後、マイクロ波電力の供給を停止するなどにより、プラズマ照射を停止し、成膜を停止する。

【 0 0 7 4 】

以上のようにして多層絶縁層 1 0 4 を形成した後、基板 1 0 1 を装置内より大気中に搬出し、ついで、ターゲット 2 0 5 として B i と T i の割合が 4 : 3 の焼結体（B i - T i - O）を用いた図 2 同様の E C R スパッタ装置の基板ホルダ 2 0 4 に、基板 1 0 1 を固定する。引き続いて、プラズマガスとしてアルゴン（A r）と酸素ガスとを用いた E C R スパッタ法により、図 1（d）に示すように、多層絶縁層 1 0 4 の上に、表面を覆う程度に、強誘電体層 1 0 5 が形成された状態とする。

【 0 0 7 5 】

強誘電体層 1 0 5 の形成について詳述すると、B i - T i - O からなるターゲット 2 0 5 を用いた図 2 に示す E C R スパッタ装置において、図示していないマイクロ波発生部より、例えば 2 . 4 5 G H z のマイクロ波（例えば 5 0 0 W）を供給し、これを導波管 2 0 8、石英窓 2 0 7、真空導波管 2 0 6 を介してプラズマ生成室 2 0 2 内に導入する。また、プラズマ生成室 2 0 2 内に、不活性ガス導入部 2 1 1 より、例えば流量 2 0 s c c m で希ガスである A r ガスを導入し、例えば流量 1 s c c m で反応ガスである O₂ ガスを導入し、例えば 1 0⁻³ P a 台の圧力に設定する。

【 0 0 7 6 】

加えて、プラズマ生成室 2 0 2 には、磁気コイル 2 1 0 にコイル電流を例えば 2 7 A を供給することで電子サイクロトロン共鳴条件の磁場を与え、上記マイクロ波の導入により、プラズマ生成室 2 0 2 に A r のプラズマが生成する。生成されたプラズマは、磁気コイ

さらにまた、酸素流量が0.5~0.8 sccmの場合は、酸素領域Aの膜と酸素領域Cの中間的な成膜となることがわかった。この酸素領域を酸素領域Bとする。

【0083】

これらの供給する酸素に対して、4つの領域に分かれて、組成変化することは今まで知られておらず、ECRスパッタ法で Bi-Ti-O の焼結ターゲットを用いて $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ を成膜した場合の特徴的な成膜特性であるといえる。

この領域を把握した上で、成膜を制御することで所望の組成と膜質の膜が得られることになる。

さらに別の厳密な測定結果より、強誘電性を明らかに示すのは、化学量論的組成が実現できている酸素領域Cであることがわかった。

【0084】

ECRスパッタ法での $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 膜の特徴は、成膜温度にも関係する。

図4は、基板温度に対する成膜速度と屈折率の変化を示したものである。この図には、図3に示した酸素領域Aと酸素領域Cと酸素領域Dに相当する酸素流量の成膜速度と屈折率の変化が示してある。図より、温度に対して成膜速度と屈折率のともに変化することがわかる。

【0085】

まず、屈折率に注目すると、酸素領域A、酸素領域C、酸素領域Dのいずれの領域に関して同様の振る舞いを示すことがわかる。

具体的には、約250℃程度までの低温領域では、屈折率は約2と小さくアモルファス的な特性を示している。300℃から600℃での中間的な温度領域では、屈折率は、約2.5と論文などで報告されているバルクに近い値となり、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ の結晶化が進んでいることがわかる。これらの数値に関しては、例えば、山口らのジャパニーズ・ジャーナル・アブライド・フィジクス、第37号、5166頁、1998年、(Jpn. J. Appl. Phys., 37, 5166 (1998).)などを参考にしたい。

【0086】

しかし、約600℃を超える温度領域では、屈折率が大きくなり表面モフォロジ（表面凹凸）が大きくなってしまい結晶性が変化しているものと思われる。この温度が、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ のキュリー温度である675℃程度に近いことを考えれば、上述した結果に矛盾はないものとする。

成膜速度の温度依存性についてみると、各酸素領域は、同じ傾向の振る舞いを示すことがわかる。具体的には、約200℃までは、温度と共に成膜速度が上昇する。しかし、約200℃から300℃の領域で、急激に成膜速度が低下する。

【0087】

約300℃に達すると成膜速度は600℃まで一定となる。この時の各酸素領域における成膜速度は、酸素領域Aが約1.5 nm/min、酸素領域Cが約3 nm/min、酸素領域Aが約2.5 nm/minであった。

以上の結果から、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ の結晶膜の成膜に適した温度は、屈折率がバルクに近くなり、成膜速度が一定となる領域であり、上述の結果からは、300℃から600℃の温度領域となる。

【0088】

一般に、強誘電性を示す材料では、キュリー温度以上では結晶性が保てなくなり、強誘電性が発現されなくなる。例えば、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ などのBiとチタンと酸素とから構成される強誘電材料では、キュリー温度が675℃付近である。このため、上述した温度の600℃に近い温度以上になると、ECRプラズマから与えられるエネルギーも加算され、膜表面の温度がキュリー温度を超えるため、強誘電性が発現されにくくなるものと考えられる。言い換えると、強誘電体層105の形成においては、基板温度の条件を、形成している膜の屈折率が急激に大きくなって一定の値を示す温度以上で、かつ、強誘電体層のキュリー温度以下とすればよいことになる。実験の結果によれば、強誘電体層105が、

•

•

続いて、上部電極 105 に負の電圧を印加すると、(1) に示すように、ほとんど電流が流れない軌跡を示すようになる。

さらに、続いて上部電極 105 に正の電圧を印加すると、(1) に示すように様に 0.5 - 1.5 V 程度まで、ほとんど電流値が流れない。

【0098】

従って、(2) の様に急激に電流が流れないように上部電極 105 に 1.5 V 以上の電圧を印加しなければ、(1) の様な電流が流れない高抵抗の状態を維持することになる。

(1) に示す状態を「正の高抵抗モード」と呼ぶことにする。例えば、(2) に示すように 1.5 V 以上の電圧を印加し、急激な電流が流れる状態とすると、(3) の様な電流が流れやすくなる低抵抗の状態になる。この状態も、上部電極 105 に正の電圧を印加している間は維持される。(3) に示す状態を「正の低抵抗モード」と呼ぶことにする。

【0099】

しかし、上部電極 105 に負の電圧を印加すると、(4) に示すように、初期に少量の電流が流れる低抵抗の状態になる。ここでも、0 から -0.4 V の間で負の電圧を印加している間、この状態が維持されるので、(4) に示す状態を「負の低抵抗モード」と呼ぶことにする。

さらに、-0.4 V 以上の負の電圧を印加すると、電流が流れなくなる高抵抗の状態になる。この状態になると、(5) に示すように、電流値が高抵抗のままが維持される。この(5) に示される状態を、「負の高抵抗モード」と呼ぶことにする。

【0100】

以上より、図 1 で示す強誘電体層を用いた素子では、「正の高抵抗モード」、「正の低抵抗モード」、「負の高抵抗モード」、「負の低抵抗モード」の 4 つのモードが安定して存在することになる。

詳細に調べると、「正の高抵抗モード」と「負の高抵抗モード」は、同じ高抵抗の状態を示す「高抵抗モード」であり、「正の低抵抗モード」と「負の低抵抗モード」は、同じ低抵抗の状態を示す「低抵抗モード」であり、2 つのモードが存在しているとも言える。

【0101】

また、各「正のモード」の実際の電流値は、0.6 V 印加時に、「正の高抵抗モード」で $5 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$ であり、「正の低抵抗モード」で $1 \times 10^{-1} \text{ A/cm}^2$ であることから、各々の比は、2000 倍にも達する。このことは、容易なモードの識別を可能にするものである。

上述した 4 つのモードをメモリ動作として応用することで、上記素子が、不揮発性で非破壊のメモリとして使用できることを、発明者らは見いだした。

【0102】

なお、上述では、強誘電体膜として $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ を用いた例を示した。しかし他のビスマスとチタンを含む強誘電体でも同様の結果が得られる。

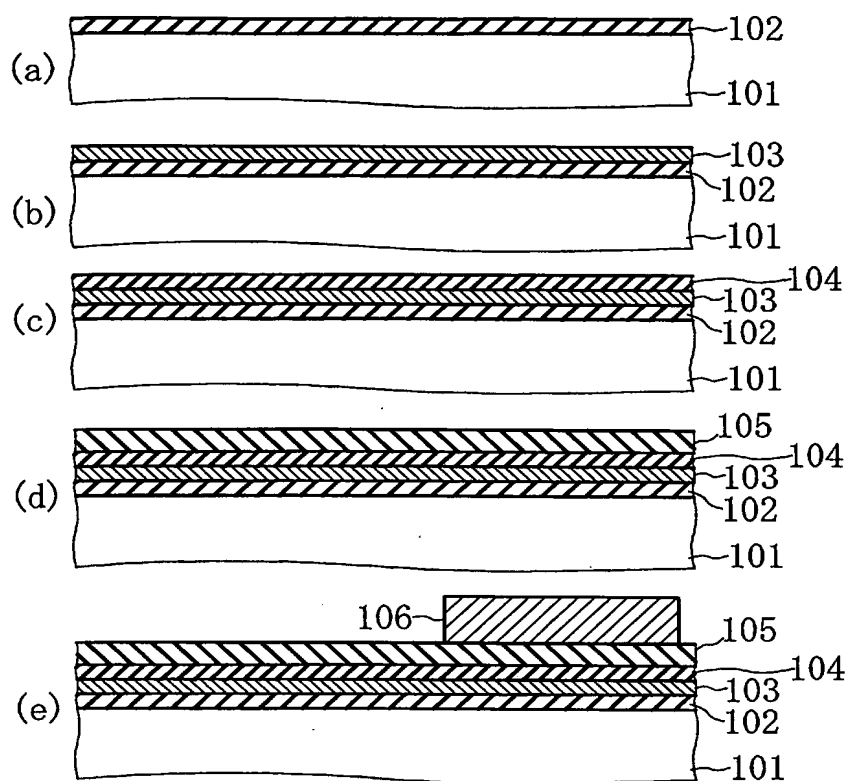
さらに、他の酸化物強誘電体も同様であり、ペロブスカイト構造を持つ材料、又は、擬イルメナイト構造を持つ材料、さらに、タングステン・ブロンズ構造を持つ材料、ビスマス層状構造を持つ材料、パイロクロア構造を持つ材料も同様の成膜が可能である。

【0103】

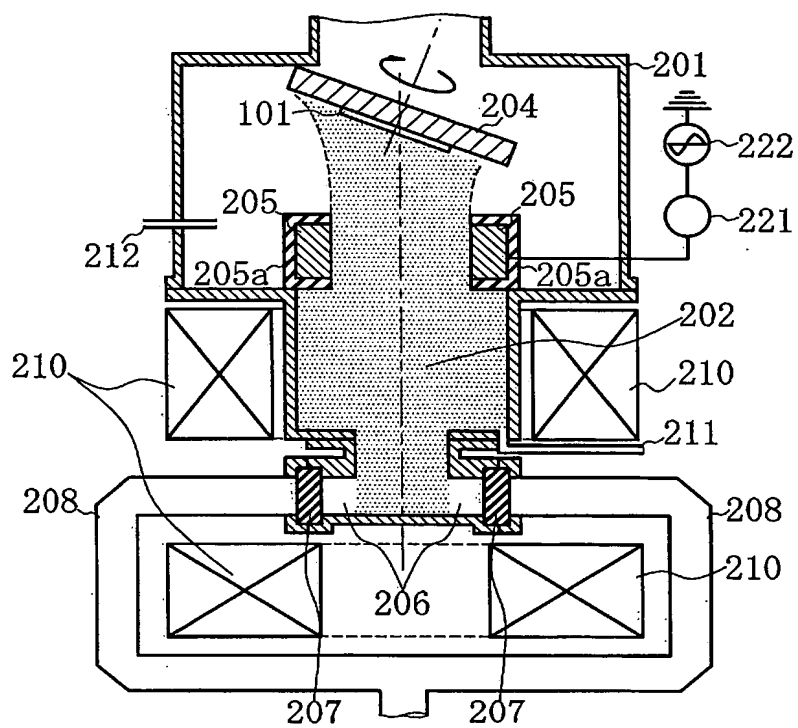
詳細には、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 、 $\text{La}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ 、 BaTiO_3 、 PbTiO_3 、 $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3$ 、 $(\text{Pb}_{1-y}\text{La}_y)(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3$ 、 LiNbO_3 、 LiTaO_3 、 KNbO_3 、 YMnO_3 など、 PbNb_3O_6 、 $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ 、 $(\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x)_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ 、 $\text{Ba}_2\text{Na}_{1-x}\text{Bi}_{x/3}\text{Nb}_5\text{O}_{15}$ 、さらに、一価、二価、三価の少なくとも一種のイオン及びこれらのイオンの組み合わせを表す記号を A とし、四価、五価、六価の少なくとも一種のイオン及びこれらのイオンの組み合わせを表す記号を B とし、酸素を表す記号を O とし、ビスマスを表す記号を Bi とし、m を 1 から 5 を表す記号としたときに、 $(\text{Bi}_2\text{O}_2)^{2+}(\text{A}_{m-1}\text{B}_m\text{O}_{3m+1})^{2-}$ で表されるビスマス層状構造を持つ強誘電体でも、同様である。

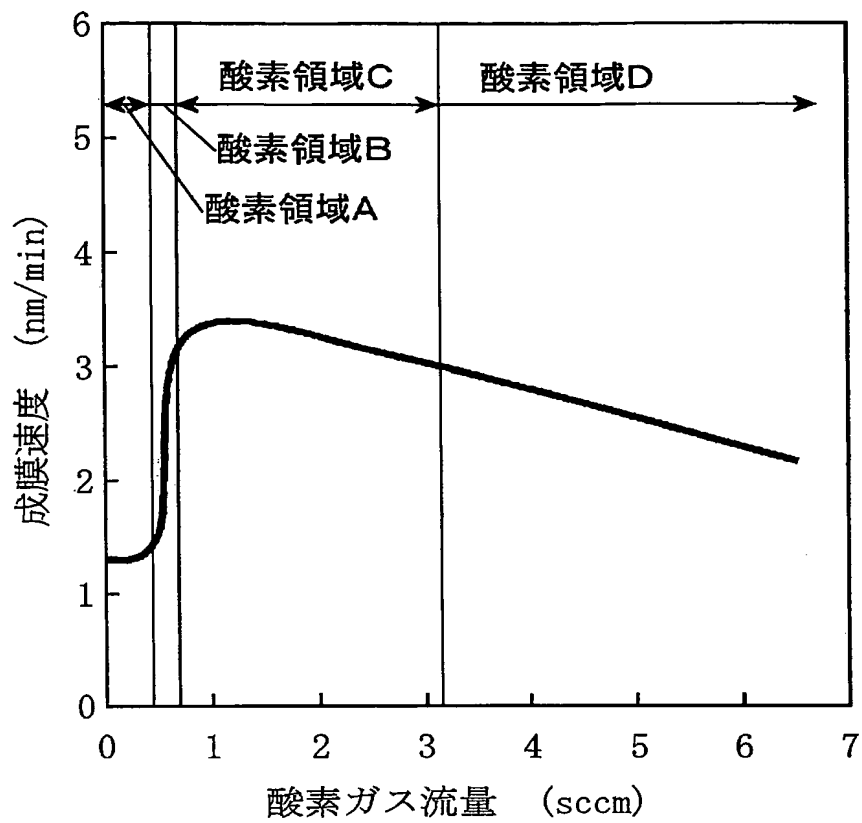
【0104】

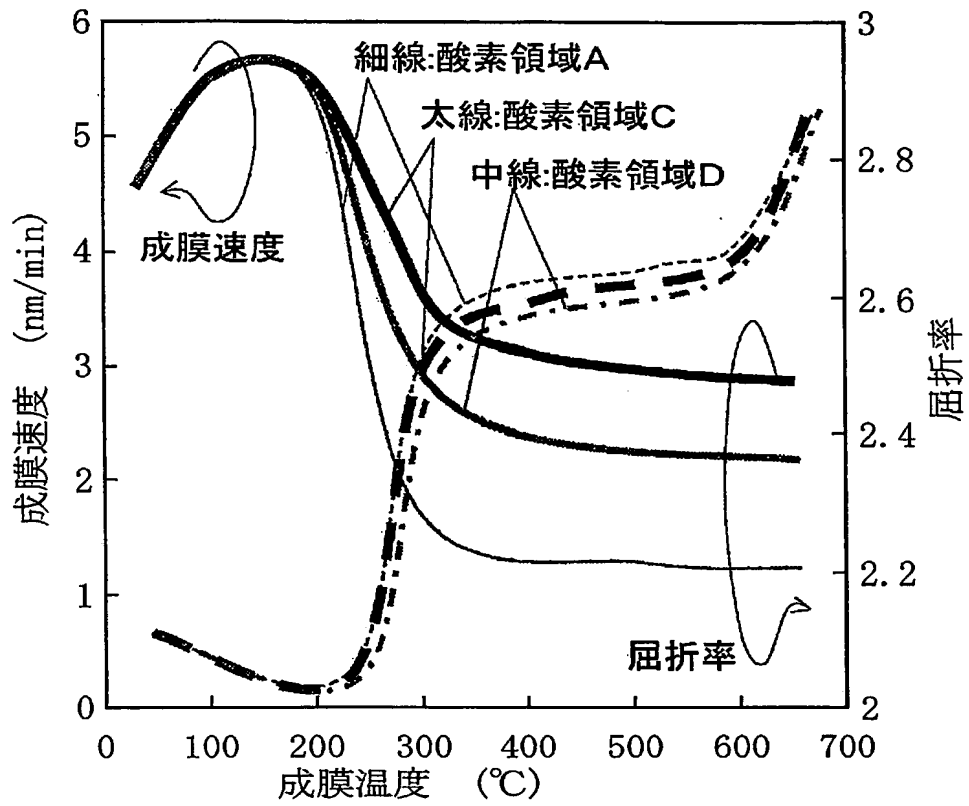
【 図 1 】



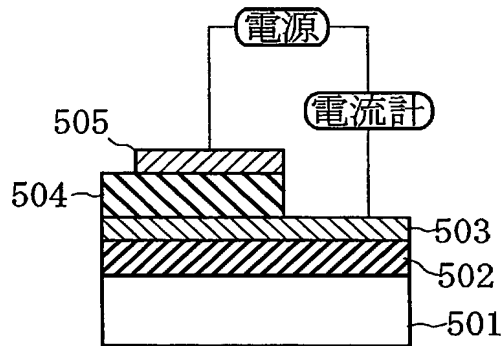
【 図 2 】

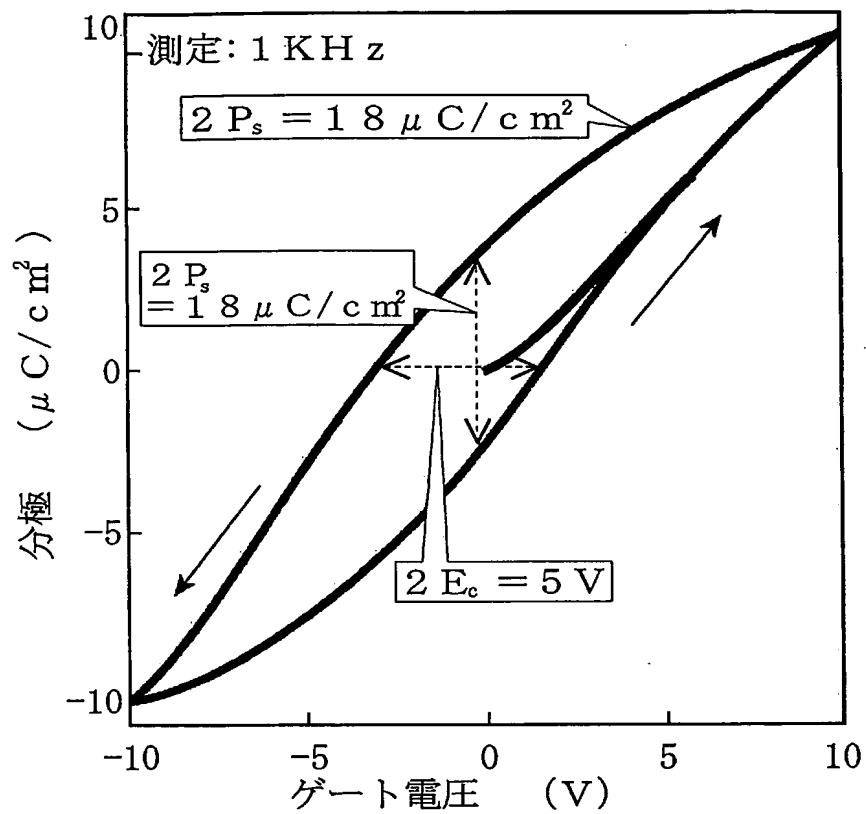


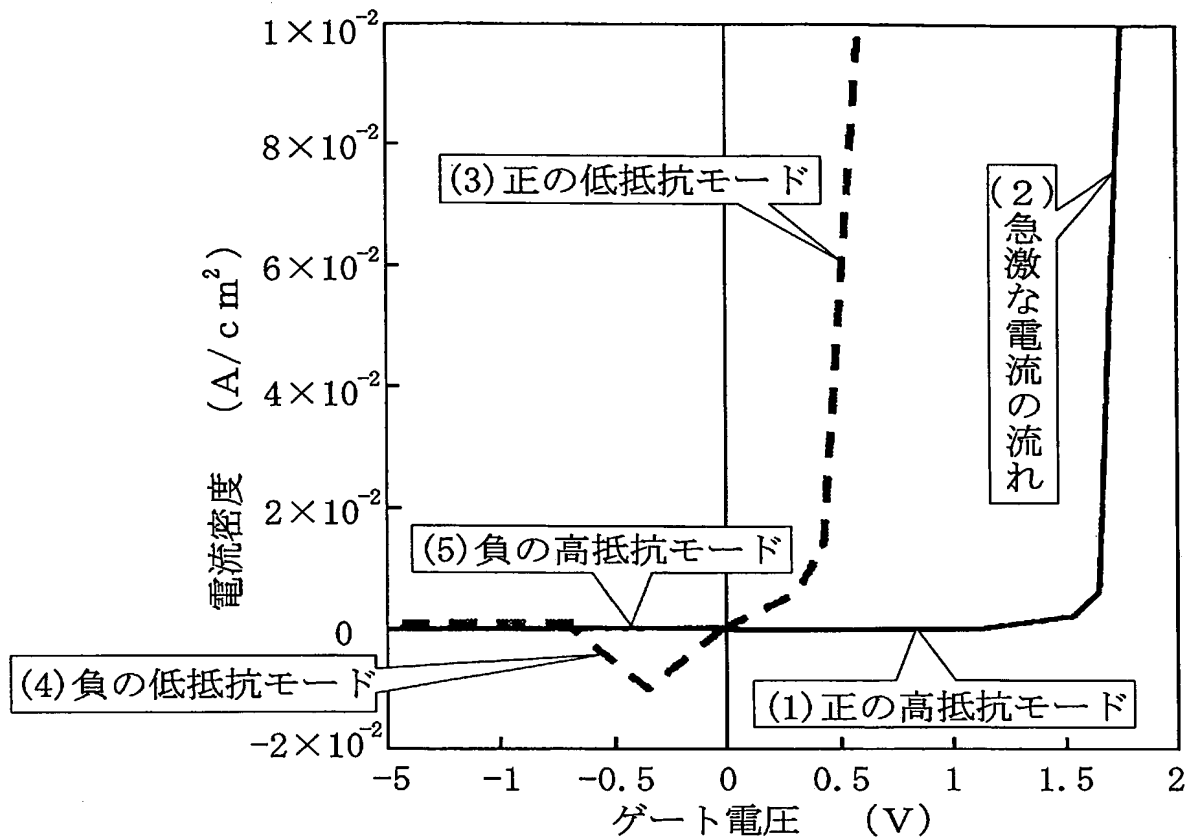




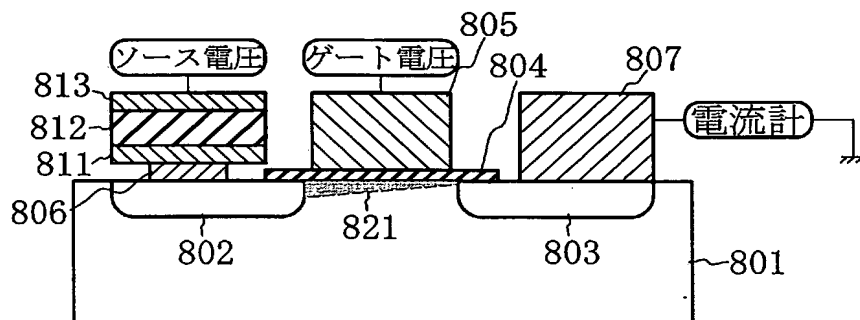
【 図 5 】



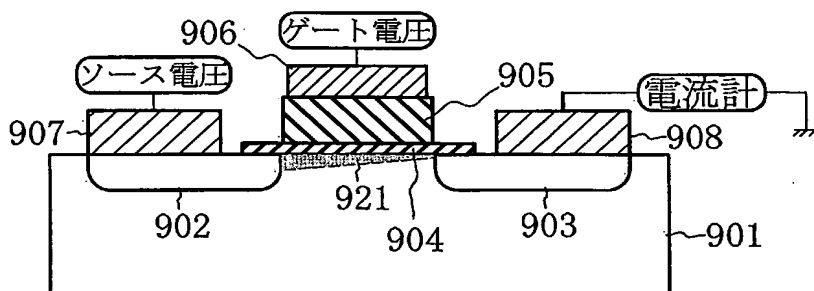




【図 8】



【図 9】



【要約】

【課題】 E C R スパッタ法において、酸素流量を制御することなどにより、良好な強誘電体特性を持つ強誘電体膜が形成できるようにする。

【解決手段】 B i と T i の割合が 4 : 3 の焼結体 (B i - T i - O) をターゲット用い、プラズマガスとしてアルゴン (A r) と酸素ガスとを用いた E C R スパッタ法により、多層絶縁層 1 0 4 の上に、表面を覆う程度に、強誘電体層 1 0 5 が形成された状態とする。例えば流量 2 0 s c c m で希ガスである A r ガスを導入し、例えば流量 1 s c c m で反応ガスである O₂ ガスを導入し、プラズマ生成室を例えば 1 0⁻³ P a 台の圧力に設定する。ターゲットより飛び出した B i 粒子と T i 粒子は、プラズマ及びプラズマにより活性化した酸素ガスと共に、多層絶縁層 1 0 4 の表面に到達し、活性化された酸素により酸化される。

【選択図】 図 1

0 0 0 0 0 4 2 2 6

19990715

住所変更

5 9 1 0 2 9 2 8 6

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

日本電信電話株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP2005/013413

International filing date: 21 July 2005 (21.07.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-214849
Filing date: 22 July 2004 (22.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 25 August 2005 (25.08.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.